



Title of Change:	Qualification of Power Schottky Top Metal And Back Metal Change for SOD 123 FL	
Proposed first ship date:	12 July 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <SitiNurhaza.MohdRamli@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <MohdAzizi.Azman@onsemi.com>.	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	There will be no change in the device marking scheme. Clean date code will be advised as requested.	
Change Category:	☒ Wafer Fab Change ☐ Assembly Change ☐ Test Change ☐ Other _____	
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☒ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Seremban, Malaysia	External Foundry/Subcon Sites: None
Description and Purpose: This is the final product change notification (FPCN) of IPCN20930X, announcing that ON Semiconductor is qualifying Power Schottky Metallization Change as below:		
	Change From	Change To
Top Metal	TiW/NiV/Au	TiW/NiV/Ag
Back Metal	Cr/Ni/Au	Ti/Ni/Ag
Products had gone thru reliability testing as per industrial requirements and it's proven that device performances are not affected.		

**Reliability Data Summary:**

QV DEVICE NAME : NRVB2H100SFT3G

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs	0/84
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc	0/84
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/100
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	1008 hrs	0/84
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hrs	0/84
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/352
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30

Electrical Characteristic Summary:

Electrical characteristics are not impacted

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
MBR120ESFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR120ESFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR120LSFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR120LSFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR120VLSFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR120VLSFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR130LSFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR140ESFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR140ESFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR140SFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR140SFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR1H100SFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR230LSFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR2H100SFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR2H200SFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR2H200SFT3G	NRVB2H100SFT3G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN20930XC

発行日 : 5 April 2019

変更件名:	SOD 123 FL パワー・ショットキー トップ・メタルおよびバック・メタルの変更認定										
初回出荷予定日:	12 July 2019										
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <SitiNurhaza.MohdRamli@onsemi.com> にお問い合わせください。										
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。										
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <MohdAzizi.Azman@onsemi.com> にお問い合わせください。										
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。										
変更部品の識別:	デバイス表示構成に変更はありません。要求に応じて、新しい日付コードを記載することをお勧めします。										
変更カテゴリ:	☒ ウェハファブの変更 ☐ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☐ その他 _____										
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製造プロセスの変更 ☒ 材料の変更 ☐ 製品仕様の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ その他: _____										
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Seremban, Malaysia	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし									
説明および目的: これは、IPC20930X の最終製品変更通知 (FPCN) であり、オン・セミコンダクターがパワー・ショットキーのメタライゼーション変更を以下の通り認定するものです。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">変更前の表記</th> <th style="width: 35%;">変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>トップ・メタル</td> <td>TiW/NiV/Au</td> <td>TiW/NiV/Ag</td> </tr> <tr> <td>バック・メタル</td> <td>Cr/Ni/Au</td> <td>Ti/Ni/Ag</td> </tr> </tbody> </table> 業界規格に基づいた信頼性試験の結果、デバイスの性能への影響がないことを認証済みです。				変更前の表記	変更後の表記	トップ・メタル	TiW/NiV/Au	TiW/NiV/Ag	バック・メタル	Cr/Ni/Au	Ti/Ni/Ag
	変更前の表記	変更後の表記									
トップ・メタル	TiW/NiV/Au	TiW/NiV/Ag									
バック・メタル	Cr/Ni/Au	Ti/Ni/Ag									



信頼性データの要約:

デバイス名: NRVB2H100SFT3G

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs	0/84
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc	0/84
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/100
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	1008 hrs	0/84
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hrs	0/84
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/352
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
MBR120ESFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR120ESFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR120LSFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR120LSFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR120VLSFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR120VLSFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR130LSFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR140ESFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR140ESFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR140SFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR140SFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR1H100SFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR230LSFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR2H100SFT3G	NRVB2H100SFT3G
MBR2H200SFT1G	NRVB2H100SFT3G
MBR2H200SFT3G	NRVB2H100SFT3G